제품 카탈로그

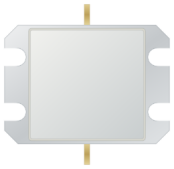
RF 전력트랜지스터

RF 전력 트랜지스터는 바이어스와 RF 구동 신호를 증폭 단계의 출력 전력으로 변환하는 능동 반도체 소자입니다. 송신 체인, 펄스 또는 CW 전력 모듈, 산업용 RF 장비, 고전력 시험 하드웨어에 사용됩니다.



제품: 11

개정: 9 · 개정일: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 51 dBm (대표값)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (대표값); 전력 이득 11 dB (대표값); PAE 45 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 5700; 최댓값: 7100; 값: 5700–7100; 단위: MHz

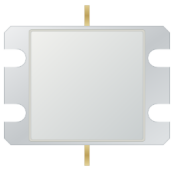
포화 출력 전력: 최솟값: 50.5; 일반값: 51; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 10.5; 일반값: 11; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 40; 일반값: 45; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 56.5 dBm (대표값)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (대표값); 전력 이득 13.5 dB (대표값); PAE 55 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2700; 최댓값: 3500; 값: 2700–3500; 단위: MHz

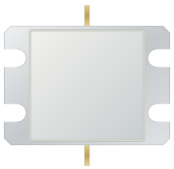
포화 출력 전력: 최솟값: 56; 일반값: 56.5; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 13; 일반값: 13.5; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 50; 일반값: 55; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 56.5 dBm (대표값)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (대표값); 전력 이득 12.5 dB (대표값); PAE 45 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 5300; 최댓값: 5900; 값: 5300–5900; 단위: MHz

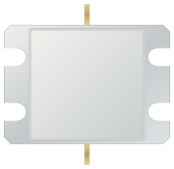
포화 출력 전력: 최솟값: 56; 일반값: 56.5; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 12; 일반값: 12.5; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 40; 일반값: 45; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 48.5 dBm (대표값)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (대표값); 전력 이득 12.5 dB (대표값); PAE 50 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2700; 최댓값: 3900; 값: 2700–3900; 단위: MHz

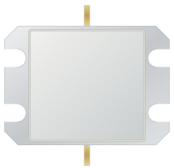
포화 출력 전력: 최솟값: 48; 일반값: 48.5; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 12; 일반값: 12.5; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 45; 일반값: 50; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 53.5 dBm (대표값)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (대표값); 전력 이득 13.5 dB (대표값); PAE 65 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2700; 최댓값: 3500; 값: 2700–3500; 단위: MHz

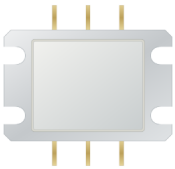
포화 출력 전력: 최솟값: 53; 일반값: 53.5; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 13; 일반값: 13.5; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 60; 일반값: 65; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 50 dBm (대표값)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (대표값); 전력 이득 12 dB (대표값); PAE 50 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2300; 최댓값: 3900; 값: 2300–3900; 단위: MHz

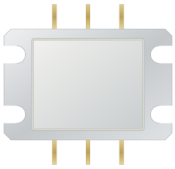
포화 출력 전력: 최솟값: 49; 일반값: 50; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 11; 일반값: 12; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 45; 일반값: 50; 단위: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 49 dBm (대표값)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (대표값); 전력 이득 13 dB (대표값); PAE 50 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2600; 최댓값: 3700; 값: 2600–3700; 단위: MHz

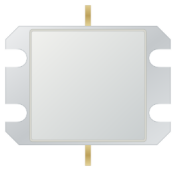
포화 출력 전력: 최솟값: 48; 일반값: 49; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 12; 일반값: 13; 단위: dB

전력 부가 효율: 최솟값: 45; 일반값: 50; 단위: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 51 dBm (대표값)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (대표값); 전력 이득 9 dB (대표값); PAE 38 % (대표값).

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 8500; 최댓값: 9600; 값: 8500–9600; 단위: MHz

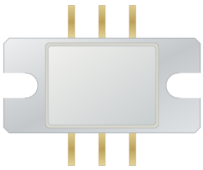
포화 출력 전력: 최솟값: 50; 일반값: 51; 단위: dBm

전력 이득: 최솟값: 8; 일반값: 9; 단위: dB

전력 부가 효율: 일반값: 38; 단위: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (대표값)

2000–6000 MHz; 참고 출력 전력 45.51 dBm (대표값); 전력 이득 19.51 dB (대표값); 드레인 효율 39.82 % (대표값) @ 6000 MHz.

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2000; 최댓값: 6000; 값: 2000–6000; 단위: MHz

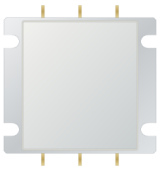
참고 출력 전력: 일반값: 45.51; 단위: dBm; 비고: f = 6000 MHz

전력 이득: 일반값: 19.51; 단위: dB; 비고: f = 6000 MHz

드레인 효율: 기호: ηD; 일반값: 39.82; 단위: %; 비고: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (대표값)

700–6200 MHz; 포화 출력 전력 49 dBm (대표값); 전력 이득 7 dB (대표값); 드레인 효율 35 % (대표값) @ 6000 MHz.

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 700; 최댓값: 6200; 값: 700–6200; 단위: MHz

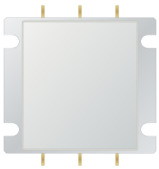
포화 출력 전력: 기호: Psat; 일반값: 49; 단위: dBm; 비고: f = 6000 MHz

전력 이득: 일반값: 7; 단위: dB; 비고: f = 6000 MHz

드레인 효율: 기호: ηD; 일반값: 35; 단위: %; 비고: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

제품 상세 제품 데이터시트



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (대표값)

2000–6200 MHz; 참고 출력 전력 50.1 dBm (대표값); 전력 이득 8.6 dB (대표값); 드레인 효율 52.4 % (대표값) @ 6000 MHz.

동작 주파수: 기호: f; 최솟값: 2000; 최댓값: 6200; 값: 2000–6200; 단위: MHz

참고 출력 전력: 일반값: 50.1; 단위: dBm; 비고: f = 6000 MHz

전력 이득: 일반값: 8.6; 단위: dB; 비고: f = 6000 MHz

드레인 효율: 기호: ηD; 일반값: 52.4; 단위: %; 비고: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.